

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И НАНОСИСТЕМ

ОДОБРЕНО НТС ЛАПЛАЗ

Протокол № 1/04-577

от 27.04.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Направление подготовки
(специальность)

[1] 12.03.05 Лазерная техника и лазерные
технологии

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/В СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экс./зач./КР/КП
7	1-2	36-72	32	0	0	4-40	0	З
8	2-3	72- 108	24	0	0	21-57	0	Э
Итого	3-5	108- 180	56	0	0	0	25-97	0

АННОТАЦИЯ

Курс является одним из центральных в обучении студентов по профилям, связанным с физикой твердого тела. Даются современные представления о конденсированном состоянии вещества, теоретические модели явлений, методы исследования, применение твердотельных эффектов в основных методах и достижениях экспериментальной физики.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные задачи курса – показать многообразие физических явлений, протекающих в конденсированной фазе вещества. Научить оценивать характерные энергии, длины, времена релаксации различных физических взаимодействий в веществе, познакомить с основными подсистемами кристаллического состояния – решеткой Браве, фононной и электронной подсистемами. Дать ориентацию в различных экспериментальных методиках и теоретических описаниях, исследующих твердое тело.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина читается на старших курсах. Ожидается, что студент уже освоил курсы общей физики, высшей математики, ТФКП, изучил или начал изучение квантовой механики и статистической физики.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
--------------------------------	--

Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
научно-исследовательской			
Анализ поставленной задачи исследований в области лазерной техники и лазерных технологий;- математическое моделирование процессов и объектов	процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом, включая биологические объекты; лазерные	ПК-1 [1] - Способен к математическому моделированию процессов и объектов лазерной техники и технологий на базе стандартных пакетов автоматизированного	З-ПК-1[1] - Знать возможности стандартных пакетов автоматизированного проектирования при математическом моделировании объектов лазерной

<p>на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, разработка программ и их отдельных блоков, отладка и настройка для решения задач лазерной техники и лазерных технологий; проведение экспериментальных исследований взаимодействия лазерного излучения с веществом; проведение измерений по заданным методикам с выбором технических средств и обработкой результатов; составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов; осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки лазерных приборов и лазерных технологических систем;</p>	<p>приборы, системы и технологии различного назначения; процессы генерации, усиления, модуляции, распространения и детектирования лазерного излучения; программное обеспечение и компьютерное моделирование в лазерной технике и лазерных технологиях.</p>	<p>проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 29.004, 40.011</p>	<p>техники и технологий.; У-ПК-1[1] - Уметь решать типичные математические задачи на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования; В-ПК-1[1] - Владеть навыками самостоятельной разработки программ при математическом моделировании процессов и объектов лазерной техники и технологий</p>
<p>Анализ поставленной задачи исследований в области лазерной техники и лазерных технологий;- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, разработка программ и их отдельных блоков, отладка и настройка для решения задач лазерной техники и</p>	<p>процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом, включая биологические объекты; лазерные приборы, системы и технологии различного назначения; процессы генерации, усиления, модуляции, распространения и детектирования</p>	<p>ПК-2 [1] - Способен к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 29.004, 40.011</p>	<p>3-ПК-2[1] - Знать основы электротехники и электроники, основы теории сигналов, основные физические методы измерений и исследований в области профессиональной деятельности.; У-ПК-2[1] - Уметь выбирать и использовать соответствующие ресурсы и оборудование для проведения</p>

<p>лазерных технологий; проведение экспериментальных исследований взаимодействия лазерного излучения с веществом; проведение измерений по заданным методикам с выбором технических средств и обработкой результатов; составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов; осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки лазерных приборов и лазерных технологических систем;</p>	<p>лазерного излучения; программное обеспечение и компьютерное моделирование в лазерной технике и лазерных технологиях.</p>		<p>исследований и измерений ; В-ПК-2[1] - Владеть методами и приемами исследований, а также навыками измерений по заданной методике в области профессиональной деятельности</p>
<p>Анализ поставленной задачи исследований в области лазерной техники и лазерных технологий;- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, разработка программ и их отдельных блоков, отладка и настройка для решения задач лазерной техники и лазерных технологий; проведение экспериментальных исследований взаимодействия лазерного излучения с веществом; проведение измерений по заданным методикам с выбором технических</p>	<p>процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом, включая биологические объекты; лазерные приборы, системы и технологии различного назначения; процессы генерации, усиления, модуляции, распространения и детектирования лазерного излучения; программное обеспечение и компьютерное моделирование в лазерной технике и лазерных технологиях.</p>	<p>ПК-3 [1] - Способен к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 29.004, 40.011</p>	<p>З-ПК-3[1] - знать основы теории измерений, основы работы с измерительной аппаратурой, основы оптико-физических измерений; ; У-ПК-3[1] - Уметь - пользоваться основными измерительными и сервисными приборами - юстировать оптические установки ; В-ПК-3[1] - Владеть методами и приемами наладки, настройки, юстировки и опытной проверки приборов и систем.</p>

<p>средств и обработкой результатов; составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов; осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки лазерных приборов и лазерных технологических систем;</p>			
<p>проектно-конструкторский</p>			
<p>Анализ поставленной проектной задачи в области лазерной техники и лазерных технологий; участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и элементов лазерных систем и технологий по заданным техническим требованиям; расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов лазерных систем и технологий на схемотехническом и элементном уровнях; разработка и составление отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы; участие в монтаже, сборке (юстировке), испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов лазерной техники и отработке элементов и</p>	<p>разработка лазерных приборов, систем и технологий различного назначения; элементная база лазерной техники, технологий, систем управления и транспорта лазерного излучения</p>	<p>ПК-4 [1] - Способен к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 29.004, 40.038</p>	<p>З-ПК-4[1] - Знать правила разработки проектной и рабочей технической документации, правила оформления конструкторской документации принципы и методы расчета и проектирования деталей и узлов приборов и установок в соответствии с техническим заданием.</p> <p>; У-ПК-4[1] - Уметь анализировать технические требования, предъявляемые к разрабатываемым узлам и элементам рассчитывать и проектировать детали и узлы приборов и установок, разрабатывать проекты технических описаний установок и приборов, проводить концептуальную и проектную проработку типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и</p>

этапов процессов лазерных технологий			элементном уровнях ; В-ПК-4[1] - Владеть методами анализа и расчета, навыками конструирования и проектирования в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях, методами расчета и проектирования деталей и узлов приборов и установок с использованием стандартных средств автоматизации
Анализ поставленной проектной задачи в области лазерной техники и лазерных технологий; участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и элементов лазерных систем и технологий по заданным техническим требованиям; расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов лазерных систем и технологий на схемотехническом и элементном уровнях; разработка и составление отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы; участие в монтаже, сборке (юстировке),	разработка лазерных приборов, систем и технологий различного назначения; элементная база лазерной техники, технологий, систем управления и транспорта лазерного излучения	ПК-5 [1] - Способен к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 29.002, 40.038	З-ПК-5[1] - Знать общие принципы, правила и методы электрических и оптикофизических измерений ; У-ПК-5[1] - Уметь выбрать метод монтажа, наладки настройки, юстировки, испытаний опытного образца разработать схему для монтажа, настройки, юстировки, испытаний формулировать и обосновывать требования к настройке, наладке, юстировке и сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники ; В-ПК-5[1] - Владеть навыками монтажа, наладки, настройки, юстировки и проведения испытаний.

испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов лазерной техники и отработке элементов и этапов процессов лазерных технологий			
Анализ поставленной проектной задачи в области лазерной техники и лазерных технологий; участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и элементов лазерных систем и технологий по заданным техническим требованиям; расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов лазерных систем и технологий на схемотехническом и элементном уровнях; разработка и составление отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы; участие в монтаже, сборке (юстировке), испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов лазерной техники и отработке элементов и этапов процессов лазерных технологий	разработка лазерных приборов, систем и технологий различного назначения; элементная база лазерной техники, технологий, систем управления и транспорта лазерного излучения	ПК-6 [1] - Способен проводить поверку, наладку и регулировку оборудования, настройку программных средств, используемых для разработки, производства и настройки приборной техники <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 29.004, 40.038	З-ПК-6[1] - Знать общие принципы, правила и методы поверки, наладки и регулировки оборудования, настройки программных средств ; У-ПК-6[1] - Уметь подготавливать испытательное оборудование и измерительную аппаратуру, выбрать метод поверки, наладки и регулировки оборудования, настройки программных средств ; В-ПК-6[1] - Владеть навыками тестирования оборудования, настройки программных средств

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал дисциплин
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование

воспитание	обеспечивающих, формирование научного мировоззрения, культуры поиска нестандартных научно-технических/практических решений, критического отношения к исследованиям лженаучного толка (В19)	воспитательного потенциала дисциплин/практик «Научно-исследовательская работа», «Проектная практика», «Научный семинар» для: - формирования понимания основных принципов и способов научного познания мира, развития исследовательских качеств студентов посредством их вовлечения в исследовательские проекты по областям научных исследований. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин "История науки и инженерии", "Критическое мышление и основы научной коммуникации", "Введение в специальность", "Научно-исследовательская работа", "Научный семинар" для: - формирования способности отделять настоящие научные исследования от лженаучных посредством проведения со студентами занятий и регулярных бесед; - формирования критического мышления, умения рассматривать различные исследования с экспертной позиции посредством обсуждения со студентами современных исследований, исторических предпосылок появления тех или иных открытий и теорий.
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование творческого инженерного/профессионального мышления, навыков организации коллективной проектной деятельности (В22)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития навыков коммуникации, командной работы и лидерства, творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и

		<p>неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР.</p> <p>2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для: - формирования производственного коллективизма в ходе совместного решения как модельных, так и практических задач, а также путем подкрепление рационально-технологических навыков взаимодействия в проектной деятельности эмоциональным эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных задач в соответствии с сильными компетентностными и эмоциональными свойствами членов проектной группы.</p>
--	--	--

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары) / Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>7 Семестр</i>						
1	Первый раздел	1-8	16/0/0		25	КИ-8	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-

							2, У- ПК-2, В- ПК-2, 3-ПК- 3, У- ПК-3, В- ПК-3, 3-ПК- 4, У- ПК-4, В- ПК-4, 3-ПК- 5, У- ПК-5, В- ПК-5, 3-ПК- 6, У- ПК-6, В- ПК-6
2	Второй раздел	9-16	16/0/0		25	КИ-16	3-ПК- 1, У- ПК-1, В- ПК-1, 3-ПК- 2, У- ПК-2, В- ПК-2, 3-ПК- 3, У- ПК-3, В- ПК-3, 3-ПК- 4, У- ПК-4, В-

							ПК-4, 3-ПК-5, У-ПК-5, В-ПК-5, 3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6
	<i>Итого за 7 Семестр</i>		32/0/0		50		
	Контрольные мероприятия за 7 Семестр				50	3	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-5, У-ПК-5, В-ПК-5, 3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6
	<i>8 Семестр</i>						
1	Первый раздел	1-8	16/0/0		25	КИ-8	3-ПК-

							1, У- ПК-1, В- ПК-1, 3-ПК- 2, У- ПК-2, В- ПК-2, 3-ПК- 3, У- ПК-3, В- ПК-3, 3-ПК- 4, У- ПК-4, В- ПК-4, 3-ПК- 5, У- ПК-5, В- ПК-5, 3-ПК- 6, У- ПК-6, В- ПК-6
2	Второй раздел	9-12	8/0/0		25	КИ-12	3-ПК- 1, У- ПК-1, В- ПК-1, 3-ПК- 2, У- ПК-2, В- ПК-2, 3-ПК- 3, У- ПК-3, В-

							ПК-3, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-5, У-ПК-5, В-ПК-5, 3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6
	<i>Итого за 8 Семестр</i>		24/0/0		50		
	Контрольные мероприятия за 8 Семестр				50	Э	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-5, У-ПК-5, В-ПК-5, 3-ПК-6, У-ПК-6

							У- ПК-6, В- ПК-6
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

* – сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
З	Зачет
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>7 Семестр</i>	32	0	0
1-8	Первый раздел	16	0	0
1 - 2	Тема 1. Металлическая связь Теплоемкость металла. Физические причины слабого затухания низкотемпературной теплоемкости металла. Статистика фононов и электронов. Химический потенциал электронов. Квазичастица «свободный электрон», ее эффективная масса, изотропный металл. Плотность электронов в металлах. Поверхность Ферми. Энергия Ферми, средняя энергия, скорость Ферми и их зависимость от концентрации электронов. Кратность вырождения электронных состояний. Вывод формулы для теплоемкости металла. Плотность состояний на поверхности Ферми. Температурная зависимость химического потенциала. Аналитические выражения и оценки величин для изотропного металла.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
3 - 4	Тема 2. Кинетические явления Кинетическое уравнение. Вывод формулы для проводимости в приближении времени релаксации. Проводимость изотропного металла, формула Друде-Лоренца. Оценка количества электронов, возбуждаемых воздействием малой энергии, количество электронов, участвующих в электропроводности. Длина свободного пробега. Основные каналы рассеяния электронов в металле. Температурная зависимость сопротивления. Оценка характерных величин длин свободного пробега и времен релаксации. Методы измерения сопротивления. Скин-эффект. Проводимость в переменном поле. Частотная зависимость глубины скин-слоя и импеданса. Нормальный и аномальный скин-эффект. Исследование топологии	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

	поверхности Ферми в измерениях ВЧ импеданса. Методы измерения импеданса. Палазменные колебания. Прозрачность металла в ультрафиолетовом диапазоне.			
5 - 6	Тема 3. Зонная структура металла Рассмотрение расширенной, повторяющейся и приведенной зонной схем на энергетических зон при квази-параболическом законе дисперсии. Принцип заполнения электронных состояний и заполнение зон квадратной решетки. Построение четырех первых зон Бриллюэна. Эволюция вида поверхности Ферми в зависимости от количества электронов, электронные и дырочные зоны. Теорема Латтинжера	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
7	Тема 4. Гальваномагнитные явления Коэффициент Холла в металлах с замкнутой поверхностью Ферми. Электронные и дырочные металлы. Эффект Холла в ферромагнитных металлах: обыкновенный и аномальный коэффициенты Холла. Четырех и пятиконтактные схемы измерения коэффициента Холла. Холловские датчики.	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
8	Тема 5. Термоэлектрические эффекты Тепло Томсона, температурная зависимость коэффициента Томсона. Тепло Пельтье, связь между коэффициентами Пельтье и Томсона. Элементы Пельтье. Эффект Зеебека, связь между термоЭДС и теплом Пельтье. Термопары для измерения высоких и низких температур, дифференциальные термопары	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
9-16	Второй раздел	16	0	0
9 - 10	Тема 6. Зонная структура и термодинамика полупроводников Симметрия зоны Бриллюэна и количество долин в кремнии и германии, эффективные массы носителей в долинах и валентных зонах. Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Плотность состояний в валентной зоне и зоне проводимости. Ширина запрещенной зоны кремния и германия и ее температурная зависимость. Расчет концентрации собственных носителей в германии. Сравнение собственной проводимости германия и кремния с проводимостью металлов. Легированные полупроводники. Донорные и акцепторные примеси, мелкие и глубокие примесные уровни, характерные глубины залегания однозарядных примесных уровней в германии и кремнии. Полупроводники p и n типа, компенсированные полупроводники. Температурная зависимость концентрации носителей, зависимость ширины области насыщения от ширины запрещенной зоны, глубины залегания примесного уровня и концентрации легирующей примеси.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
11 - 12	Тема 7. Неравновесные носители заряда Монополярная и биполярная генерация. Типы рекомбинации: излучательная, безизлучательная и ударная (Оже). Центры рекомбинации и прилипания. Сечения захвата электронов и дырок. Связь времени жизни носителей с параметрами полупроводника и ловушек в	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

	модели Шокли-Рида. Характерные времена жизни носителей в собственных и примесных полупроводниках.			
13 - 14	Тема 8. Диффузия и дрейф Неоднородные пространственные распределения неравновесных носителей. Поверхностная генерация и рекомбинация. Уравнение непрерывности. Диффузия и дрейф. Диффузионная длина и радиус экранирования. Биполярная диффузия. Установление электронейтральности при биполярной диффузии. Эффект Дембера. Расчет напряжения между освещенной и неосвещенной поверхностью полупроводника при поверхностном поглощении света.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
15 - 16	Тема 9. Контактные явления Оценка основных характеристик р-n- перехода: величины потенциального барьера, ширины двойного обедненного слоя, напряженности поля в обедненном слое, емкости перехода. Инжекция и экстракция. Лавинный пробой. Световая генерация и рекомбинация носителей в р-n- переходах. Вентильный фотоэффект: плотность тока короткого замыкания, напряжение холостого хода. Светодиод: соотношение между излучаемой энергией и выделяемым теплом, между длиной волны излучения и масштабом напряжения на переходе. Полупроводниковый лазер.	Всего аудиторных часов		
		4	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
	<i>8 Семестр</i>	24	0	0
1-8	Первый раздел	16	0	0
1	Тема 1. Поглощение в полупроводниках Прямые, непрямые переходы. Экситонное поглощение. Примеси и свободные носители.	Всего аудиторных часов		
		1	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
1	Тема 2. Фотопроводимость Фотомагнитный эффект. Вывод формулы для ЭДС фотомагнитного эффекта. Фотомагнитомеханический эффект. Люминесценция. Флюоресценция. Механизмы люминисценции в полупроводниках	Всего аудиторных часов		
		1	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
2	Тема 3. Сегнетоэлектричество Сегнетова соль. Физические основы. Применение	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
3	Тема 4. Эффект Холла в полупроводниках Коэффициент Холла и магнитосопротивление. Температурная и полевая зависимость. Методы измерения и интерпретации экспериментальных данных. Эффект Эттингсгаузена Особенности поведения магнитосопротивления для многозонных веществ.	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
4	Тема 5. Гетероструктуры на основе полупроводников Уровни размерного квантования и двумерный электронный газ. Сверхрешетки. Квантовый эффект Холла	Всего аудиторных часов		
		2	0	0
		Онлайн		
		0	0	0
5	Тема 6. Циклотронный резонанс Циклотронный резонанс, эксперимент Азбеля-Каннера.	Всего аудиторных часов		
		2	0	0

	Эффективная циклотронная масса. Получение информации о зонной структуре.	Онлайн	0	0	0
6	Тема 7. Эффект де-Гааза-ван-Альфена Уровни Ландау. Условия проведения эксперимента. Построение поверхностей Ферми. Гигантские квантовые осцилляции поглощения ультразвука в металлах. Восстановление зонной структуры.	Всего аудиторных часов	2	0	0
		Онлайн	0	0	0
7	Тема 8. Гамма-резонансная спектроскопия Эффект Мессбауэра, «мессбауэровские» изотопы. Интерпретация мессбауэровских спектров. Изомерный сдвиг. Квадрупольное расщепление, расщепление уровней ядра в магнитном поле соседних электронов. Фактор Лэмба-Мессбауэра. Влияние температуры на мессбауэровские спектры	Всего аудиторных часов	2	0	0
		Онлайн	0	0	0
8	Тема 9. Аннигиляция позитронов в веществе Аннигиляция позитронов в веществе – диагностика электронной структуры. Основы метода. Источники позитронов. Схема эксперимента для измерений двухквантовой аннигиляции позитронов. Интерпретация экспериментальных данных. Комптоновское рассеяние как альтернатива аннигиляционного метода.	Всего аудиторных часов	2	0	0
		Онлайн	0	0	0
9-12	Второй раздел		8	0	0
9	Тема 10. Метод ядерного магнитного резонанса в физике твердого тела Основы метода. Спектры ЯМР. Продольная и поперечная релаксация. Ядра, представляющие интерес для ЯМР-спектроскопии. Интерпретация спектров ЯМР: положение, интенсивность, дисперсия тонкой структуры. Сдвиг Найта.	Всего аудиторных часов	1	0	0
		Онлайн	0	0	0
9	Тема 11. Метод электронного парамагнитного резонанса Основы метода. Отличия метода ЭПР от ЯМР-метода. Спектры ЭПР, спин-решеточная и спин-спиновая релаксация. Интерпретация спектров ЭПР.	Всего аудиторных часов	1	0	0
		Онлайн	0	0	0
10	Тема 12. Двойные резонансы Акустический парамагнитный резонанс, акустический ядерный магнитный резонанс, двойной электронно-ядерный резонанс. Общие представления.	Всего аудиторных часов	2	0	0
		Онлайн	0	0	0
11	Тема 13. Фотоэмиссия и EXAFS Фотоэмиссионные и инверсные фотоэмиссионные спектры. Методы XANES, EXAFS – исследование электронной подсистемы твердого тела.	Всего аудиторных часов	2	0	0
		Онлайн	0	0	0
12	Тема 14. Жидкие кристаллы Смектики и нематики. Элементарное описание. Применение.	Всего аудиторных часов	2	0	0
		Онлайн	0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс

ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы
АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении данной дисциплины основную роль играют аудиторные занятия, а также самостоятельная работа студентов, заключающаяся в выполнении домашнего задания, изучении пройденного материала. Для того чтобы показать современное физическое состояние физики конденсированного состояния вещества, предусмотрено широкое использование современных научных работ и публикаций по данной теме, посещение лабораторий НИЯУ МИФИ. Рекомендуется посещение студентами научных семинаров и конференций, в том числе, проводимых в НИЯУ МИФИ, а также в других московских университетах и институтах.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие (КП 1)	Аттестационное мероприятие (КП 2)
ПК-1	З-ПК-1	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-1	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-1	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
ПК-2	З-ПК-2	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-2	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-2	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
ПК-3	З-ПК-3	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-3	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-3	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
ПК-4	З-ПК-4	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-4	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-4	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
ПК-5	З-ПК-5	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-5	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-5	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
ПК-6	З-ПК-6	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-6	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-6	З, КИ-8, КИ-16	Э, КИ-8, КИ-12

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89	4 – «хорошо»	B	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		C	
70-74		D	
65-69	3 – «удовлетворительно»	E	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
60-64			
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ А 71 Введение в теорию полупроводников : , Санкт-Петербург: Лань, 2022

2. ЭИ С 65 Материалы и элементы электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики : учебное пособие, Санкт-Петербург: Лань, 2022
3. ЭИ А 71 Основы статистической физики и термодинамики : , Санкт-Петербург: Лань, 2022
4. ЭИ З-24 Сборник задач по физическому материаловедению : учебно-методическое пособие, Москва: НИЯУ МИФИ, 2021
5. ЭИ Ш 18 Физика полупроводников : учебное пособие, Санкт-Петербург: Лань, 2022
6. ЭИ С 77 Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие для вузов, Москва: Юрайт, 2022
7. 539.2 К45 Введение в физику твердого тела : , Ч. Киттель , М.: МедиаСтар, 2006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 539.1 Я 34 Ядерный магнитный резонанс в структурных исследованиях : монография, Москва: КРАСАНД, 2017
2. 539.2 А98 Физика твердого тела Т.1 , , М.: Мир, 1979

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

<https://online.mephi.ru/>

<http://library.mephi.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

При изучении курса необходимо твердо усвоить современные представления о кристаллических структурах, о методах их экспериментального определения, о фононной и электронной подсистемах твердого тела, о классификации твердых тел. Следует изучить основные методы определения фононного спектра, плотности фононных состояний. Понимать значение фактора Дебая-Валлера в амплитуде рассеяния. Иметь представление о дефектах структуры, об элементарных возбуждениях. Знать особенности ионной связи, расчета постоянной Маделунга.

Необходимо уметь оценивать характерные параметры различных подсистем в конденсированной фазе, уметь ориентироваться в многообразии физических явлений твердого состояния. Знать особенности электронной подсистемы твердого тела, вид блоховской

волновой функции, особенности зонной структуры и движения блоховского электрона во внешних полях. Уметь объяснить различие металла и диэлектрика, полуметалла и полупроводника. Рассчитывать статистику электронов и дырок, понимать значение эффективной массы для динамики носителей заряда. Знать основные методы определения концентрации носителей и знака их заряда, методы расчета зонной структуры, примесных состояний.

Необходимо владеть современными теоретическими представлениями при описании взаимодействий атомов и электронных оболочек в кристалле, о термодинамических, оптических, магнитных и электрофизических свойствах твердых тел, а также представлять основные резонансно-магнитные и другие экспериментальные методы.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Необходимо дать студентам основные представления об электронной и фононной подсистемах твердого тела.

Курс опирается на материал следующих дисциплин, читаемых студентам физико-математических специальностей: уравнения математической физики, квантовая механика, макроэлектродинамика, теория вероятностей, статистическая физика и термодинамика. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по курсам общей физики и университетскому курсу математики. Необходимо проверить умение работать с операторами, знать дифференциальное и интегральное исчисление, тензорный и векторный анализ, статистику и термодинамику, электричество и магнетизм, в том числе в материальных средах. Необходимо, чтобы студенты ориентировались в задачах квантовой механики и статистической физики, основные квантовые и классические распределения, элементы квантовой статистики. В процессе освоения материала следует дать основные представления об электронной и фононной подсистемах твердого тела, о классификации межатомных связей, слагающих конденсированное состояние, о различных методах экспериментального исследования этих подсистем. Следует рассказать об основных общепринятых теоретических представлениях о физических процессах в твердых телах, об отличии твердого состояния от других агрегатных состояний вещества. Необходимо научить понятию о дальнем и ближнем порядке, о дефектах кристаллической структуры, о кинетических и термодинамических свойствах и моделях, описывающих эти свойства.

Автор(ы):

Кашурников Владимир Анатольевич, д.ф.-м.н.,
профессор

Кузнецов Алексей Владимирович, к.ф.-м.н.

